

ALD装置

Atomic Layer Deposition System

EALD-4



■概要

原子層堆積法により、1原子層レベルで膜厚を制御し、均一で高品質且つ段差被膜性の高い薄膜を形成することが可能です。

■特長

1. トップフロー方式を採用し、より均一な成膜が行えます。
2. 材料を独立した配管とMFCでチャンバーへ接続する事で材料ラインのコンタミを防ぎます。
3. チャンバーを2重構造にする事で温度分布が向上し、膜厚の均一性も向上します。
4. 様々な研究目的に対する拡張に対応します。
オプション: LL室接続、GB接続、TMP排気、オゾン発生器等

■仕様

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 1. 基板サイズ | : φ 100mm(4インチ) |
| 2. 膜厚分布 | : ±2%(φ 100mm範囲) |
| 3. 到達圧力 | : 1Pa(ドライポンプ) |
| 4. 加熱温度 | : 400°C(ニクロム線ヒーター) |
| 5. プリカーサー | : 標準4系統(200°C加熱) |
| 6. ALDバルブ | : ダイアフラムバルブ |
| 7. 装置寸法 | : 600(W)×800(D)×1,400(H) |